PEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 209886

@Int Cl.4

證別記号

广内整理番号

母公開 昭和62年(1987)9月16日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称

分布帰還型半導体レーザ

顧 昭61-52862 の特

顧 昭61(1986)3月10日 四出

考 ②発 明

30代 理 人

桑村

東京都港区芝5丁目33番1号

日本電気株式会社

有 司

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

の出 願 人

弁理士 内 原

明細音

発明の名称

分布帰還型半事体レーザ

特許讃求の範囲

半導体基板上に少なくとも活性層と前記活性層 よりもエネルギーギャップが大きく、かつ一方の 面に回折裕子が形成された光ガイド層とを有する 分布帰還型半導体レーザにおいて、少なくとも一 方の光出射面に波長選択性のある多層膜を有して いることを特徴とする分布帰還型半導体レーザ。 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本苑明は分布帰還型半導体レーザに関する。 (従来の技術)

同期構造(回折格子)をレーザ反射機構として利用 する分布帰遺型半導体レーザ(以下DFBレーザと略 す)は、紫子内部に設けた回折格子の周期で定まる ブラッグ波長近傍で単一軸モード発振し、高速直 接変調時にも単一軸モード動作を維持するため、

光ファイバの大容匱長波長伝送システムの光源と して有望視されている。

(苑明が解決しようとしている問題点)

DFBレーザは、紫子内部に形成した回折格子に よる反射率の波長依存性によって選択的に一本の 軸モードを発振させようとするものであるが、通 常のDFBレーザでは、ブラッグ波長で発振せず、 ブラッグ波長をはさむ2本の軸モードが発振しやす い。この原因を以下簡単に説明する。第3図は、通 常よく試作されるDFBレーザで、共振器の片端面 での反射率R1を0とし、残りの端面での反射率R2が 0.3の時(この反射率はへきかい面での反射率とほぼ 一致する)、規格化波長ABLに対する反射鏡損失 aLを示したものである。第3図から明らかなように 反射競損失aLの最小値は、ブラッグ波長に存在し ない。しかも、反射鏡損失aLはブラッグ波長を中 心として左右ほぼ対称な形となっているため、し きい値利得の極小値はブラッグ波長をはさんだ両 側に存在することになる。このため、通常の DFBレーザでは、ブラック波長をはさむ2本の縦 モードが発掘する確率が高くなり、単一モードで発振するDFBレーザの歩留りを悪くする原因となっている。そこで単一軸モード発振するDFBレーザの歩留りをよくするためには、1)発振しきい値利得の最小値をブラッグ反射と一致させる、2) ΔβL対αL曲線(規格化波長に対する反射鏡損失曲線)をブラッグ波長を中心として左右非対称な形にする、ことなどが有効となってくる。

1)のタイプのレーザにおいては、通常のDFB-LDの共振器方向のほぼ中心で回折格子の位相をπだけずらすことを特徴とする。通常のDFB-LDにおいては、回折格子のブラッグ波及に相当する励振光の前進波と回折格子による反射波の位相がキャビティ方向の中心でπだけことなる。つまり、両者の波がたがいに打ち消し合うため、ブラッグ波及での発振に必要な利得が高くなり、この波及の光は励振されない。そこでレーザのキャビティ方向の中央で回折格子の位相をπだけずらしてやると回折格子による1次の反射光は、前進波と同位相となり

ブラッグ波長でのレーザ発振が可能となる。この 原理を利用したのが 1)の改良点である。

事実 1)の改良点に着目したM4シフト型DFBレー ザの試作例が1984年11月22発行エレクトロニクス レターズ施第20巻4号1008~1010項に報告されてお り、ブラッグ波及に一致した単一軸モード発振す るDFBレーザが(ペレットで評価した歩留りとして は)歩留りよく得られている。しかし、上記の方法 では2/4シフト型回折格子を有する基板を形成する 工程を行なわねばらなず、この工程でのカイ4シフト 型悲板作製の歩留りも問題となる。事実、上記の 論文では、悲板上にポジ型及びネガ型のフォトレ ジストを隣接して形成し、二光東干渉露光法によ り焼きつけを行った後、半導体基板をエッチング する工程によりM4シフト型回折格子を形成してい るため、両者のレジスト最適露光時間が異なるこ となどの問題点があり2/4シフト型回折格子を有す る基板を形成する工程での歩留りは決してよいと はいえない。

本苑明は、上記の2)の改良点に若目し、安定に 単一軸モードで発振するDFBレーザの製造歩留り を向上させることにある。

(問題点を解決するための手段)

本苑明の要旨とするところは、ΔβL対αL曲線を ブラッグ波長に対して左右非対称な形にするため、DFBレーザの少なくとも一方の光出射面に波 長進択性のある多層膜ほどこすことにある。

(作用)

本発明の作用について述べる前に従来型の多層 腰を有するDFBレーザと本発明の被長選択性のあ る多層膜を有するDFBレーザとの違いについる 初に明確にしておく。従来、DFBレーザの出力端 面に多層膜を形成する目的としては、第2図の故線 で示したような特性すなわちレーザ端面での反射 率を高反射にするために多層膜を形成していた。 ところが本発明における多層膜は、第2図の突線で 示したように波長の変化に対して反射率が変化す るような波長選択性を有する多層膜をDFBレーザ 端面に形成することにある。両者の違いは多層膜 の層数、層厚などのパラメータが大幅に異なる。一例として発振波長が1.3µmのDFBレーザを例にとってみると、従来例では多層膜(具体例としてSiO2とa-Siの多層膜を考えている)の層数が5層のものが多く、SiO2の層厚は2240Å、a-Siの層厚は1091Åである。ところが本発明の多層膜では多層膜の層数が従来型のものより多く18層必要でSiO2の層厚は2740Å、a-Siの層厚は1333Åと設計パラメータが大幅に異なっている。

本発明の多層膜の作用を以下簡単に説明する。第4図は、DFBレーザの片端面の反射率R1を0とし、残りの端面での反射率R2をパラメータと7、DFBレーザの規格化相対発振波及ΔβLに対する反射競損失αLを計算したものである。第4図から明らかなようにDFBレーザのしきい値利得は、反射率R2に依存している。本発明はこの効果を利用したものである。そこで今、波曼が受くなるにつれて(第4図ではΔβLが負から正に変化するにつれて)端面反射率R2がしだいに高くなるような特性を有する多層膜をDFBレーザのへき開面に形成すること

を考える。このフィルタを形成することで ΔBL<0側で発振可能な軸モードのしきい値利得 ... は、ΔBL>0側のそれより小さくすることができ、 ΔβL<0側の軸モードを進択的に発振させることが できる。このようすを第4図でながめてみると従米 型では第4図の実線5のようなブラッグ波長に対し て左右対称なΔBL-aL特性を示したものを本発明の 効果により第4図の波線6のようなブラッグ波長に 対して左右非対称なΔβL-aL特性にすることができ る。これにより反射鏡損失配の極小部は従来2ヵ所 の波長で存在していたものが1ヵ所で存在するよう になり、単一軸モードのみが選択的に発振する確 率が高くなる。以上は一方の光出射面に旋長退択 性のある膜を施した例で説明したが、この事情は 両方の出射面に多層膜を形成した場合も同様であ る。

(実施例)

第1図は、本発明の構成を明示するための全体構成図である。本発明は、DFBレーザ1の一方のへき 開面に無反射コーティング(又は低反射膜)膜4を形

ドで発振されやすくなる。また、DFBレーザの端面での回折格子の位相Qは素子作製時に制御することは不可能であるからDFBレーザの歩留りは位相Qがある発版利得差△aL以上になる確率を評価することにより定量的に比較できる。今、両者の標道のDFBレーザを比較すると従来型構造のDFBレーザでは、△aL>0.1が41%,△aL>0.2が25%,△aL>0.3が12%となっているのに対し、本発明のDFBレーザでは△aL>0.1が74%,△aL>0.2が45%,△aL>0.3が20%となっている。以上のことから、本発明によりDFBレーザの製造歩留りが向上することがわかる。

(発明の効果)

DFBレーザの少なくとも一方の光出射面に波及 選択性のある多層膜フィルタを形成することによ り従来型のDFBレーザより高い確率で単一铀モー ド発振する繁子がえられる。

図面の簡単な説明

第1図は本発明のDFBレーザの端而構造を示した 概造図、第2図は多層版フィルタの波長に対する反

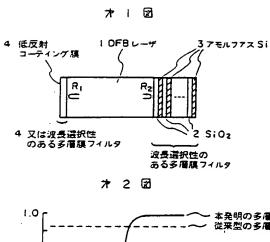
成し、残りのへき開面にSiO22、アモルファス Si3を順次n層(nは正の整数)積層した多層膜を形成 することにより罅成される。第2図は、一例として 多層膜を18層積層した時の各波長に対する反射率 を計算したものである。ここでSiO22の屈折率は1. 46、 層厚は0.274 μmで、 アモルファス Si3の 屈折率 は3、層厚は0.1333µmとした。このような構造の多 **層膜は、第2図に示したように急峻な波長依存性を** 有しており、本発明の効果を十分に発揮できる。 このことを実証するために第5図には上記の多層版 フィルタを形成したDFBレーザのΔβL対αL曲線の 計算結果を示す。ここでkL=0.5とした。第5図 は、第3図と比較するとΔBL対aL曲線がブラッグ波 長に対して非対称な曲線が得られることがわか る。 第6図 a) はR1=0,R2=0.31の 従 米 型DFB レー ザ。第6図 b)は本発明のDFBレーザのR2側端面の位 相Qに対するメインモードとサブモードの発振利得 差ΔαLの関係を示したものである。発振利得差 ΔαLは、軸モードの安定性を評価する上で重要なパー ラメータであり、この値が大きいほど単一軸モー

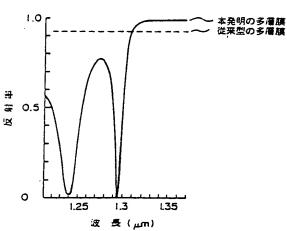
射率依存性を示した図、第3図は従来型のDFBレーザの規格化発振波長ΔβL村反射競損失αLを示した図、第4図は、従来型のDFBレーザで端面の反射率 R2を変化させた時のΔβL村αL曲線を示す図、第5図は本発明のDFBレーザにおけるΔβL村αL曲線を示す図、第6図a)は従来型、b)は本発明のDFBレーザにおいて端面位相Qに対するDFBレーザのメインモードとサブモードの利得差ΔαLを示した図である。

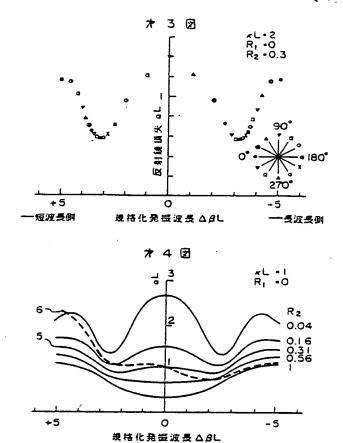
図中、1はDFBレーザ、2はSiO₂、3はアモルファ スSi、4は低反射コーティング膜である。

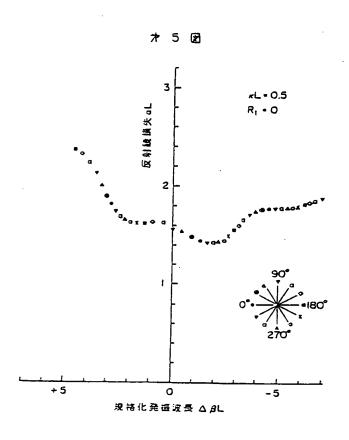
代理人 弁理士 内原

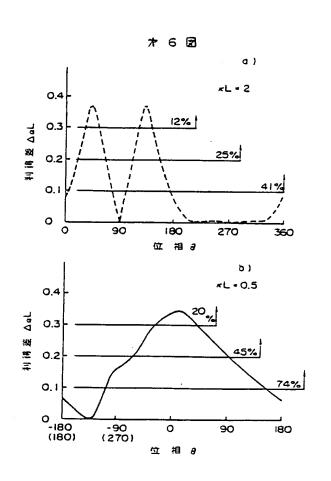
持開昭62-209886(4)











PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62209886 A

(43) Date of publication of application: 16.09.87

(51) Int. CI	H01S 3/18			
(21) Application number: 61052862		(71) Applicant:	NEC CORP	
(22) Date of filing: 10.03.86		(72) Inventor:	KUWAMURA YUJI	•

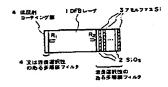
(54) DISTRIBUTED FEEDBACK TYPE SEMICONDUCTOR LASER

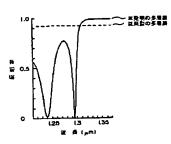
(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a uniaxial-mode oscillating element in high probability by forming a multilayer film filter having wavelength selectivity on at least one light emitting surface of a distributed feedback type semiconductor (DFB) laser.

CONSTITUTION: A nonreflecting coating (or low reflecting film) film 4 is formed on one cleaved surface of a DFB laser 1, and a multilayer film in which n (n: positive integer number) of SiO $_2$ films 2 and amorphous Si 3 are sequentially laminated on the remaining cleaved surface is formed. The multilayer film of such a structure has an abrupt wavelength dependency to provide nonsymmetrical $\Delta\beta$ L- α L characteristic for Bragg wavelength. Thus, the minimum of the reflecting mirror loss α L exists at one position to enhance the probability of selectively oscillating only in a uniaxial mode.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:				
BLACK BORDERS				
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES				
☐ FADED TEXT OR DRAWING				
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING				
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES				
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS				
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS				
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT				
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY				
Потнер.				

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.